

PHOTOFLASH RECTIFIER

VOLTAGE RANGE 1000 to 1800 Volts CURRENT 0.5 Ampere

FEATURES

- * High reliability
- * Low leakage
- * Low forward voltage drop
- * High current capability

MECHANICAL DATA

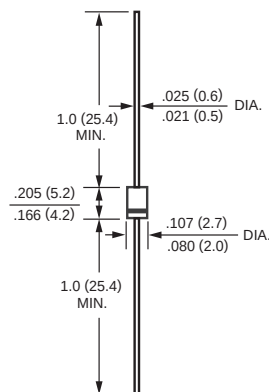
- * Case: Molded plastic
- * Epoxy: Device has UL flammability classification 94V-0
- * Lead: MIL-STD-202E method 208C guaranteed
- * Mounting position: Any
- * Weight: 0.20 gram

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.



A-405



Dimensions in inches and (millimeters)

MAXIMUM RATINGS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	RL1N1000F	RL1N1200F	RL1N1400F	RL1N1600F	RL1N1800F	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	VRRM	1000	1200	1400	1600	1800	Volts
Maximum RMS Voltage	VRMS	700	840	980	1120	1260	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	VDC	1000	1200	1400	1600	1800	Volts
Maximum Average Forward Current at TA = 55°C	Io	500					mAmps
Peak Forward Surge Current IFM (surge): 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	IFSM	30					Amps
Typical Junction Capacitance (Note 2)	Cj	10					pF
Operating and Storage Temperature Range	TJ, TSTG	-55 to + 150					°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	RL1N1000F	RL1N1200F	RL1N1400F	RL1N1600F	RL1N1800F	UNITS
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 0.5A DC	VF	1.8					Volts
Maximum DC Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage TA = 25°C	IR	5.0					uAmps
Maximum Full Load Reverse Current Average, Full Cycle .375" (9.5mm) lead length at TL = 55°C		100					uAmps
Maximum Reverse Recovery Time (Note 1)	trr	300					nSec

NOTES : 1. Test Conditions: IF = 0.5A, IR = -1.0A, IRR = -0.25A

2. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts

2002-12

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (RL1N1000F THRU RL1N1800F)

FIG. 1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE

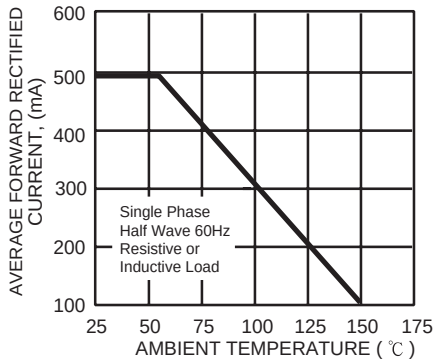


FIG. 2 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

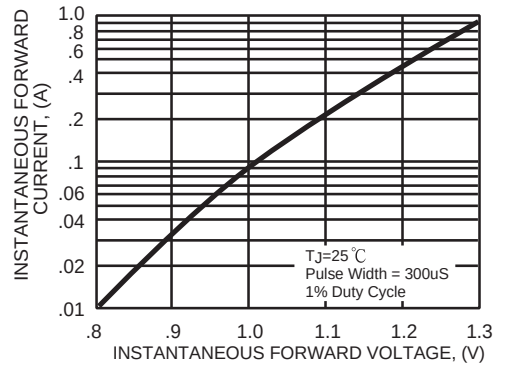


FIG. 3 - MAXIMUM NON-REPETITIVE SURGE CURRENT

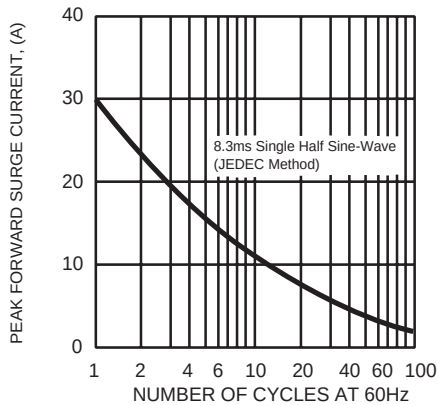


FIG. 4 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE

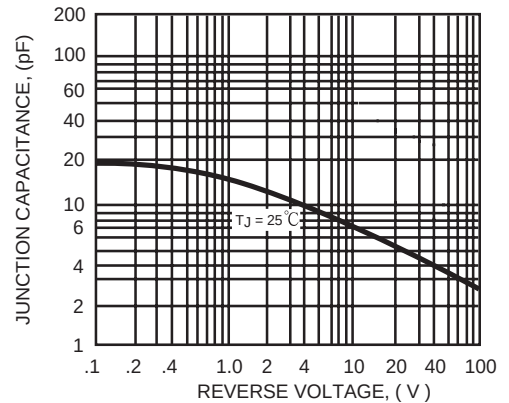
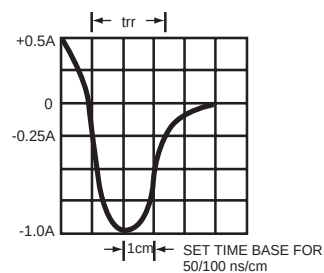
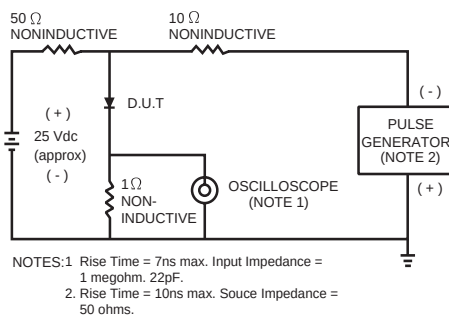


FIG. 1 - TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9